Электрофизические свойства и структура YBa₂Cu₃O_y, термически восстановленного после низкотемпературного распада

© И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, Е.П. Романов

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: bobylev@imp.uran.ru

(Поступила в Редакцию 22 сентября 2009 г. В окончательной редакции 25 ноября 2009 г.)

Исследованы электрофизические свойства и структура нестехиометрического ВТСП-соединения $YBa_2Cu_3O_y$, восстановленного при $t = 930-950^{\circ}C$ после низкотемпературного распада ($t = 200^{\circ}C$) на фазы, различающиеся по содержанию кислорода. Показано, что в отличие от термообработок при $t \le 900^{\circ}C$ наблюдается практически полное восстановление сверхпроводящих свойств в течение 3-5 h, происходящее в ходе рекристаллизации зерна, что невозможно при более низких температурах. После относительно непродолжительного отжига при $t = 930-950^{\circ}C$ (1-2 h) в керамике еще сохраняется значительное количество дефектов структуры, вероятно, в катионных подрешетках, которые способны осуществлять пиннинг магнитных вихрей, что приводит к существенному повышению критической плотности тока в магнитных полях до 2 T по сравнению с керамикой, полученной по стандартной технологии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-03-00041).

Особенностью нестехиометрического YBa2Cu3Ov является его неустойчивость при температурах < 400°С относительно распада на две фазы, различающиеся содержанием кислорода ($y \sim 6.2 \text{ u} \sim 7$) [1]. В ходе распада происходит выделение частиц размером 5-10 nm [2], т.е. формируется своего рода естественный нанокомпозит, образующийся в ходе фазового превращения. Согласно фазовой диаграмме [1], в зависимости от начального содержания кислорода при условии достижения равновесия выделяющиеся частицы либо обеднены кислородом $(y \sim 6.2)$, либо обогащены им $(y \sim 7)$. В процессе длительной термообработки ($\tau \ge 100 \, \mathrm{h}$) при $t = 200^\circ \mathrm{C}$ данное фазовое расслоение приводит к переходу матричной фазы в псевдокубическое состояние из-за разупорядочения кислорода и появления дефектов в катионных подрешетках вследствие возникающих в ходе распада напряжений вокруг выделившихся частиц [3,4]. При этом существенную роль играет характер газовой фазы. Кинетика распада различна в окислительной и нейтральной атмосферах [3]. Кроме того, формированию псевдокубической фазы способствует присутствие в атмосфере паров воды [5]. Эти структурные изменения сопровождаются ухудшением критических характеристик образцов с относительно высоким содержанием кислорода (y > 6.8), вплоть до полной потери сверхпроводимости [3].

В [6] показано, что, согласно рентгенографическим данным, имеет место аналогия между структурой и свойствами образцов, претерпевших низкотемпературный распад, и материалами, подвергнутыми облучению высокотемпературными частицами, а также со структурой керамики, синтезированной при $t < 900^{\circ}$ С. Это может свидетельствовать об однотипности искажения равновесной структуры, возникающего в ходе всех этих процессов вследствие разупорядочения как в катионных,

так и в анионной подрешетках. Данное обстоятельство представляет интерес в связи с результатами работы [7], в которой было установлено, что дефекты структуры, возникающие в процессе облучения высокоэнергетическими частицами, являются эффективными центрами пиннинга, способствующими увеличению критической плотности тока.

В настоящей работе исследовано восстановление структуры и электрофизических свойств образцов с кислородным индексом $y \approx 6.8$, 6.5 и 6.3 после распада при $t = 200^{\circ}$ С в течение 100 h в проточной атмосфере аргона. Восстановление проводили при t = 930 и 950°С в течение 1–8 h, с последующим окислением в атмосфере кислорода при $t = 400^{\circ}$ С (24 h) с целью достижения кислородного индекса $y \sim 7$.

Рентгеноструктурное исследование выполнено на дифрактометре типа ДРОН-3М в медном излучении. Измерения магнитной восприимчивости проводили на квантовом СКВИД-магнитометре типа MPMS-XL-5 фирмы Quantum Design на частоте 80 Hz при амплитуде переменного поля 4 Ое. Электросопротивление измеряли стандартным четырехконтактным методом, а критическую плотность тока — импульсным методом при *T* = 77 К. В качестве материала для исследования была использована однофазная керамика (по данным рентгеновского анализа), приготовленная с помощью стандартного твердофазного синтеза (максимальная температура синтеза 950°С). Содержание кислорода $y \approx 6.8, 6.5$ и 6.3 достигалось с помощью термообработки полученных образцов при t = 500, 700 и 900°C соответственно в течение 24h [1]. Перед восстановительными отжигами образцы подвергались помолу и прессованию, так как в процессе распада под действием возникающих напряжений происходит разрыхление структуры керамики, вплоть до образования макротрещин [3], что затрудняет

спекание и формирование микроструктуры, характерной для температур 930–950°С.

Ранее нами было установлено, что в ходе отжигов при $t \le 900^{\circ}$ С с последующим окислением при $t = 400^{\circ}$ С образование характерной для $y \sim 7$ структуры не происходит [6,8]. По данным электронно-микроскопического исследования в зависимости от содержания кислорода и условий низкотемпературного отжига наблюдаются либо структура, возникшая в процессе распада (как правило, черно-белый контраст), либо переходная структура с еще не вполне сформировавшимися двойниками. На рентгенограммах также не разрешаются группы линий, расщепление которых связано с ромбическим искажением решетки 123 [6].

После отжигов при $t = 930-950^{\circ}$ С с последующим окислением в атмосфере кислорода степень восстановления структуры и свойств значительно выше. Как видно из рис. 1, термообработка при $t = 930^{\circ}$ С в течение 1 h приводит к расщеплению рефлексов 200-020-006, однако линии уширены на 15-40% и сближены на $\sim 0.1^{\circ}$ по сравнению с керамикой с $y \sim 7$, не подвергавшейся распаду. Увеличение продолжительности отжига до 5-8 h приводит к сужению линий и восстановлению характерного ромбического искажения (рис. 1, показано стрелками). При этом ромбическое искажение увеличивается в основном за счет роста параметра *b*. В ходе отжигов при $t = 950^{\circ}$ С процесс идет аналогичным образом, однако полное восстановление рентгенографической картины наблюдается уже после 5 h.

Согласно результатам измерений магнитной восприимчивости χ , отжиг при $t = 930^{\circ}$ С в течение 1 h с последующим окислением до $y \sim 7$ приводит к восстановлению сверхпроводимости во всем объеме образца, о чем свидетельствует величина диамагнитного отклика (рис. 2). Однако температура перехода несколько понижена ($T_c \sim 88$ K), а сам переход существенно более ши-



Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм образцов $YBa_2Cu_3O_{6.8}$ после распада и восстановления в различных режимах с последующим окислением. $I - t = 200^{\circ}C$, 100 h в атмосфере Ar; $2 - t = 930^{\circ}C$, 1 h; $3 - t = 930^{\circ}C$, 5 h; $4 - t = 930^{\circ}C$, 8 h.



Рис. 2. Температурные зависимости магнитной восприимчивости $\chi'(a)$ и $\chi''(b)$ образцов YBa₂Cu₃O_{6.8} после распада и восстановления в различных режимах с последующим окислением. $I - t = 200^{\circ}$ С, 100 h в атмосфере Ar; $2 - t = 930^{\circ}$ С, 1 h; $3 - t = 930^{\circ}$ С, 2 h; $4 - t = 930^{\circ}$ С, 5 h; $5 - t = 950^{\circ}$ С, 1 h; 6 — керамика, полученная по стандартной технологии с y = 6.96.

рокий по сравнению с керамикой, полученной по стандартной технологии. Более широкий переход, а также пониженная T_c , по-видимому, связаны с сохранением еще достаточно большого количества структурных дефектов, образовавшихся в процессе распада. Существенно более высокий максимум на зависимости $\chi'' = f(T)$, вероятно, связан с меньшим размером зерна, так как основной вклад в его интенсивность определяется потерями на перемагничивание межзеренных границ при переходе их в сверхпроводящее состояние [9].

Увеличение продолжительности отжига при $t = 930^{\circ}$ С до 2 h приводит к сужению перехода и увеличению T_c . После отжига в течение 5 h критическая температура возрастает до ~ 92 K, а зависимости $\chi' = f(T)$ и $\chi'' = f(T)$ становятся практически идентичными соответствующим зависимостям, характерным для керамики, полученной по стандартной технологии (рис. 2, кривые 4 и 6). Таким образом, пятичасовой отжиг при $t = 930^{\circ}$ С практически полностью устраняет дефекты структуры, возникающие при низкотемпературном распаде.

Термообработка при $t = 950^{\circ}$ С в течение 1 h приводит к более полному восстановлению свойств по сравнению с аналогичной обработкой при $t = 930^{\circ}$ С. Кроме того, в этом случае имеет место более высокий диамагнитный отклик, а также пониженные потери на перемагничивание границ при *T* < 77 К по сравнению с керамикой, не претерпевшей распада (рис. 2, кривые 5). При этом зерно остается еще достаточно мелким, о чем свидетельствует существенно более высокий максимум на зависимости $\chi'' = f(T)$. Обращает на себя внимание довольно "вялое" начало перехода в сверхпроводящее состояние, что может свидетельствовать о сохранении части дефектов структуры в теле зерна. Дальнейшее увеличение продолжительности отжига при $t = 950^{\circ}$ С полностью восстанавливает характер зависимостей $\chi' = f(T)$ и $\chi'' = f(T)$.

Измерения магнитной восприимчивости хорошо согласуются с результатами резистивных измерений, которые также указывают на то, что отжиг при $t = 930^{\circ}$ С в течение 1-2h не полностью устраняет дефектность структуры, возникающую в процессе распада. Об этом свидетельствуют несколько пониженные значения Т_с (R = 0) (соответственно 87 и 89 K), а также уширенный переход в сверхпроводящее состояние ($\Delta T \approx 4 \,\mathrm{K}$). Следует отметить, что понижены не только значения T_{c} (R = 0), но и температуры начала перехода. Последнее, по-видимому, также свидетельствует о повышенной дефектности в объеме зерна, в то время как значения T_c (R = 0) характеризуют состояние межзеренных границ. Тем не менее значения критической плотности тока в нулевом поле в обоих случаях близки к соответствующим значениям для керамики, полученной по стандартной технологии ($\approx 300 \,\text{A/cm}^2$).

В [10] установлено, что при $t \ge 920^{\circ}$ С имеет место сильная рекристаллизация зерна. Из полученных в настоящей работе результатов следует, что полное восстановление структуры и свойств УВа2Си3О, происходит в этой же области температур. Данное обстоятельство позволяет предположить, что рекристаллизация играет важную роль в этом процессе. На это также указывают и ранее полученные результаты [6,8], согласно которым при $t = 900^{\circ}$ С наблюдается лишь частичное восстановление структуры и свойств, несмотря на то, что при данной температуре подвижность катионов является достаточно высокой. Таким образом, можно сделать вывод, что для полного восстановления требуются более высокие температуры, так как в пределах зерна, претерпевшего распад, равновесная для $t \le 900^{\circ}$ С структура не достигается, и, следовательно, требуются условия, при которых за счет зерен, содержащих большое количество дефектов и обладающих соответственно более высокой свободной энергией образования, сформировались новые зерна с уже равновесной структурой.

Причина необратимости свойств и структуры при $t \le 900^{\circ}$ С, вероятно, заключается в том, что помимо



Рис. 3. Полевые зависимости критической плотности тока. 1 — керамика, полученная по стандартной технологии (12 wt.% Ag); 2 — та же керамика после распада в атмосфере Ar при $t = 200^{\circ}$ C (100 h) и восстановления при $t = 930^{\circ}$ C (2 h) с последующим окислением; 3 — керамика, полученная по стандартной технологии без добавления Ag.

расслоения по кислороду в процессе низкотемпературного распада возникают серьезные нарушения на атомном уровне, такие как взаимозамещения катионов [11] и дефекты упаковки [4]. Частичное восстановление структуры после термообработки при $t \leq 900^{\circ}$ С, выражающееся в некотором увеличении ромбического искажения, может свидетельствовать о том, что, наряду с указанными выше дефектами, имеют место смещения катионов из своих положений равновесия, устранение которых не требует рекристаллизации зерна. Поэтому при $t \leq 900^{\circ}$ С возможно частичное упорядочение кислорода, о чем и свидетельствует повышение ромбического искажения по сравнению с состоянием, возникшим после распада.

В [6] сделано предположение, что образующиеся в ходе низкотемпературного распада дефекты структуры, в первую очередь те, что возникают в катионных подрешетках, могут служить центрами пиннинга и способствовать повышению критической плотности тока в высоких магнитных полях при условии, что их количество оптимально. Для проверки этого предположения нами были выполнены измерения критической плотности тока j_c в полях до ~ 2 Т. На рис. 3 представлены зависимости $j_c = f(B)$ для двух образцов, содержащих 12 wt.% серебра, один из которых получен по стандартной керамической технологии, а второй был отожжен при $t = 200^{\circ}$ С в течение 100 h в атмосфере аргона. После этого он был обработан при $t = 930^{\circ}$ С в течение 2 h и окислен до у \sim 7. Серебро ($\sim 1 \, \mu m$) вводили с целью улучшения межзеренной связанности [12], а также в качестве частиц несверхпроводящей фазы, которые также могут способствовать пиннингу магнитных вихрей и приводить к повышению значений *j*_c. Для сравнения на рис. З также приведена полевая зависимость для керамики, не содержащей серебра.

Как видно из рис. 3, контрольный образец теряет сверхпроводящие свойства в поле $\sim 1 \text{ T}$ (кривая *I*), в то время как керамика, претерпевшая распад, сохраняет сверхпроводимость в поле $\geq 2 \text{ T}$, несколько снижая j_c по мере увеличения *B*. Это свидетельствует о том, что сохранение части дефектов структуры, возникших в ходе распада, действительно может быть использовано для получения материалов типа 123 с повышенной токонесущей способностью в высоких магнитных полях.

Авторы выражают благодарность сотрудникам центра коллективного пользования ИФМ УрО РАН А.В. Королеву за проведение измерений магнитной восприимчивости, а также В.А. Сазоновой и М.В. Чунтоновой за проведение рентгенографических измерений исследованных образцов.

Список литературы

- И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, С.В. Сударева, Т.П. Криницина, Л.Н. Кузьминых, Ю.В. Блинова, Е.П. Романов. ФММ 102, 550 (2006).
- [2] С.В. Сударева, Е.И. Кузнецова, Т.П. Криницина, И.Б. Бобылев, В.Н. Морычева, Л.В. Жердева, Е.П. Романов. ФММ 75, 125 (1993).
- [3] И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, С.В. Сударева, Е.П. Романов. ФММ 103, 420 (2007).
- [4] С.В. Сударева, Е.П. Романов, Т.П. Криницина, Е.И. Кузнецова, Ю.В. Блинова, И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, А.М. Бурханов. ФММ 106, 378 (2008).
- [5] Z. Rupeng, M.J. Gorige, S. Muhra, P.S. Turner. Phil. Mag. A 66, 491 (1992).
- [6] И.Б. Бобылев, Н.А. Зюзева, Е.П. Романов. ФММ 106, 388 (2008).
- [7] W. Schindler, B. Roas, G. Saemann-Ischenko, L. Schultz, H. Gerstenberg. Physica C 169, 117 (1990).
- [8] И.Б. Бобылев, Е.И. Кузнецова, Т.П. Криницина, Н.А. Зюзева, С.В. Сударева, Е.П. Романов. ФММ 107, 549 (2009).
- [9] Е.З. Мейлихов. СФХТ 2, 5 (1989).
- [10] S.M. Johnson, M.I. Gusman, D.J. Roweliffe. Adv. Ceram. Mater. 2, 337 (1987).
- [11] Ю.В. Блинова, С.Г. Титова, С.В. Сударева, Е.П. Романов. ФТТ **51**, 1041 (2009).
- [12] G. Kozlowski, I. Maartense, R. Spyker, R. Leese, C.E. Oberly. Physica C 173, 195 (1991).